第10回コアリション・コンファレンス@東北大学 2023年12月5日

X線タイコグラフィ装置の整備計画と 試料・測定・像再生について

高橋幸生

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター





X線タイコグラフィ:レンズレス顕微X線イメージング法



- 1. コヒーレントX線ビームをそのビームサイズより大きな拡がった試料に照射
- 記料を光軸垂直面内にビームの一部が重複するように二次元走査し、走査各点で回折強度パターンを取得
 回折強度パターンに反復的位相回復計算を実行し、プローブ、試料像を再構成
 - マイクロメートルオーダーの広い視野とナノメートルスケールの高い空間分解能

X線タイコグラフィによる観察例@SPring-8

真空中(5keV~8keV)@BL29XU



126, 14047-14057 (2022)

反応生成物の分布



元素の価数分布



H. Uematsu et al., J. Phys. Lett. 12, 5781-5788 (2021) 粒子内部の 化学状態不均一性



K. Shimomura et al., Opt. Express 26, 31199-31208 (2018)

配線中の欠陥

大気開放型(8keV)@BL24XU

粒子充填材料



末広ら,塗装工学 56,204-210 (2021); 砂川ら, SPring-8/SACLA利用研究成果集11, 153-155 (2023)

粒子の分散状態

ポリマーブレンド(ABS樹脂)



相分離構造

BL10U:X線コヒーレントイメージングビームライン



X線タイコグラフィ装置整備計画



X線タイコグラフィ装置整備計画1:利用開始予定2024年5月頃~

2023年12月2日 試料チャンバー&ステージ、検出器チャンバー&調整機構をSPring-8より移設



2024年5月頃~ 単一エネルギー(5keV~8keV)での2次元タイコグラフィ測定

X線タイコグラフィ装置整備計画2:利用開始予定2024年10月頃~

- 2024年8月 全反射集光鏡(高橋)、 大気開放型試料ステージ(高山)の導入
- 2024年8月~9月 装置調整
- 集光光学系:FZP or 全反射集光鏡
- ↓ 試料:真空中 or 大気
 - 画像検出器:EIGER 1M

Advanced KB全反射集光鏡





2024年10月頃~ 可変エネルギー(5keV~8keV)での2次元/3次元タイコグラフィ測定

X線タイコグラフィ装置整備計画3:利用開始予定2025年1月頃~



2025年1月頃~ 可変エネルギー(2.1keV~8keV)での2次元/3次元タイコグラフィ測定

X線タイコグラフィ装置整備計画4:利用開始予定2025年度~



2025年度~ 単一エネルギー(2.1keV~8keV)での2次元/3次元タイコグラフィ測定

試料加工および標準的な測定条件

試料加工例



標準的な測定条件

	2D投影	3D CT	2D XANES
試料形状	基板支持·薄片等	柱状加工・キャピラリー封入等	基板支持·薄片等
観察視野	10 μ m \sim (150 μ m)	数µm~10 µm強	数µm~5 µm強
計測時間	1分~(1時間)	3時間~10時間	3時間~
画素サイズ	20 nm \sim (6 nm)	20 nm \sim	20 nm \sim

※今後の性能向上で計測時間短縮や空間分解能向上の見込みがあります。

像再生ソフトウェアについて

■基本的なタイコグラフィ像再生ソフトウェアはビームラインに整備する予定である(ソフトウエアの外部持ち出し不可)。専門家の技術的な指導は必要となる。

コヒーレンスモードを考慮した再構 成計算、試料位置ドリフト補正する 再構成計算、XAFSのスペクトル フィッティング解析、CT再構成な ど高度な解析は専門家との共同研究 で進める必要がある。

MATLABで作成したソフトウェア





- □ 1回のビームタイムで必ずしも結果が出るものではなく、 試料加工形状や測定条件の検討に複数回のビームタイムを 費やすことが多い。
- X線タイコグラフィ計測・解析は高度な技術を要するため、 東北大SRIS教員との共同研究をお願いします。
 - ✓ 計測・解析を請け負うだけの共同研究は実施いたしません。
 公表可能な学術的課題の提供をお願いします。
 - ✓ 社内課題解決に継続的にご利用して頂くために、技術を習得可能な 共同研究員を派遣して頂くことをお願いします。
 - ✓ 装置立ち上げから参加される共同研究員を大歓迎いたします。

X線タイコグラフィに関心のある方はお気軽にご相談ください

X線タイコグラフィで再構成される試料の物理情報

複素透過関数



位相シフト:X線入射方向に対する**試料電子密度分布の投影**を反映 振幅の減衰率:試料によるX線の吸収を反映

吸光度
$$\mu t(\mathbf{r}, E) = -2 \ln |T(\mathbf{r}, E)|$$
 $\left\{ \mu : 線吸収係数 \right\}$

元素吸収端で振幅の大きさのエネルギー依存性を調べることで X線吸収微細構造(XAFS)を取得できる⇒スペクトロタイコグラフィ